
	<h2 style="color: #e67e22;">SI5410DU-T1-GE3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI5410DU-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 40V 12A PPAK CHIPFET</p> <p>Datenblätter:  SI5410DU-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

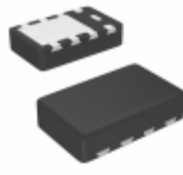
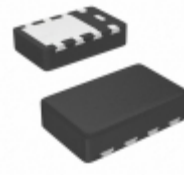

Spezifikationen

Teilenummer	SI5410DU-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 40V 12A PPAK CHIPFET
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® ChipFet Single
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	18 mOhm @ 6.6A, 10V
Verlustleistung (max)	3.1W (Ta), 31W (Tc)
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® ChipFET™ Single
Andere Namen	SI5410DU-T1-GE3CT
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1350pF @ 20V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	32nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 40V 12A (Tc) 3.1W (Ta), 31W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	12A (Tc)

SI5410DU-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI5410DU-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI5410DU-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI5410DU-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI5410DU-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 40V 12A PPAK CHIPFET</p>	 <p>SI5414DC-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 20V 6A 1206-8</p>	 <p>SI5411EDU-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 12V 25A PPAK CHIPFET</p>	 <p>SI5406DC-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 12V 6.9A 1206-8</p>
 <p>SI5406DC-TI-E3 VISHAY VISHAY SOT-163</p>	 <p>SI5406DP-TI-E3 VISHAY SI5406DP-TI-E3 VISHAY</p>	 <p>SI5415AEDU-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 20V 25A CHIPFET</p>	 <p>SI5406DC-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 12V 6.9A 1206-8</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SI5410DU-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SI5410DU-T1-GE3 Datenblatt	SI5410DU-T1-GE3-Datenblätter	SI5410DU-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SI5410DU-T1-GE3
SI5410DU-T1-GE3 Electronic	SI5410DU-T1-GE3-Komponenten	SI5410DU-T1-GE3-Verteiler	SI5410DU-T1-GE3-Bild	SI5410DU-T1-GE3-Teil
SI5410DU-T1-GE3 Preis	SI5410DU-T1-GE3 Hersteller	SI5410DU-T1-GE3 Bild	SI5410DU-T1-GE3 Aktie	SI5410DU-T1-GE3 Inventar
SI5410DU-T1-GE3 Neu	SI5410DU-T1-GE3 Original	SI5410DU-T1-GE3 garantiert	SI5410DU-T1-GE3 RFQ	SI5410DU-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited